Реєстраційна картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0108U010726

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 17-12-2008

II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК):

У тому числі по роках:
Загальний обсяг фінансування: 20 тис. грн.

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи: Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги, 10, м. Київ, Київ, 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442878922, 0442878922

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи: Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: пр. Науки, 41, м. Київ, Київська обл., 03028, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380445254020

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Нанокомпозитні тонкі плівки в металізації напівпровідникових приладів на основі нітриду галію та карбіду кремнію для високопотужної електроніки

Назва роботи англійською:

Nanocomposite thin films in metallization of semiconductor devices based on gallium nitride and silicon carbide for high - power electronics

Мета роботи українською:

Мета роботи - визначення меж та перспектив використання розроблених схем електричних контактів, для металізації напівпровідникових приладів на основі нітриду галію та карбіду кремнію в високо - потужній, - температурній електроніці. Основні результати - (а)проведено дослідження електричних властивостей, мікроструктури та термостабільності контактів на основі Au,-Pd до GaN та Ni-,Si до SiC, (б) синтезовано та проведено комплексне дослідження дифузійних бар'єрів на основі нанокомпозитних тонких плівок Ta(Ti)-Si-N (товщина < 100 нм), (в) розроблено надійні, термічно стабільні Омічні контакти до GaN та SiC, на основі нанокомпозитних Ta(Ti)-Si-N дифузійних бар'єрів з монтажною плівкою Au.

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Інше

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Підвищення термічної стабільності електронних приладів. Отримання нанокомпозитних плівок з наперед заданими властивостями.

Галузь застосування:

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Кучук Андріан Володимирович

Науковий ступінь:

Наукове звання:

Ідентифікатор ORCHID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Нанокомпозитні тонкі плівки в металізації напівпровідникових приладів на основі нітриду галію та карбіду кремнію для високопотужної електроніки

Початок етапу: 07.2008

Закінчення етапу: 12.2008

Вид звітного документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 539.2;538.9-405;548, 539.213; 529.23+621.793.79; 539.26

Коди тематичних рубрик: 29.19

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Мачулін Володимир Федорович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності Юрченко Т.А.